



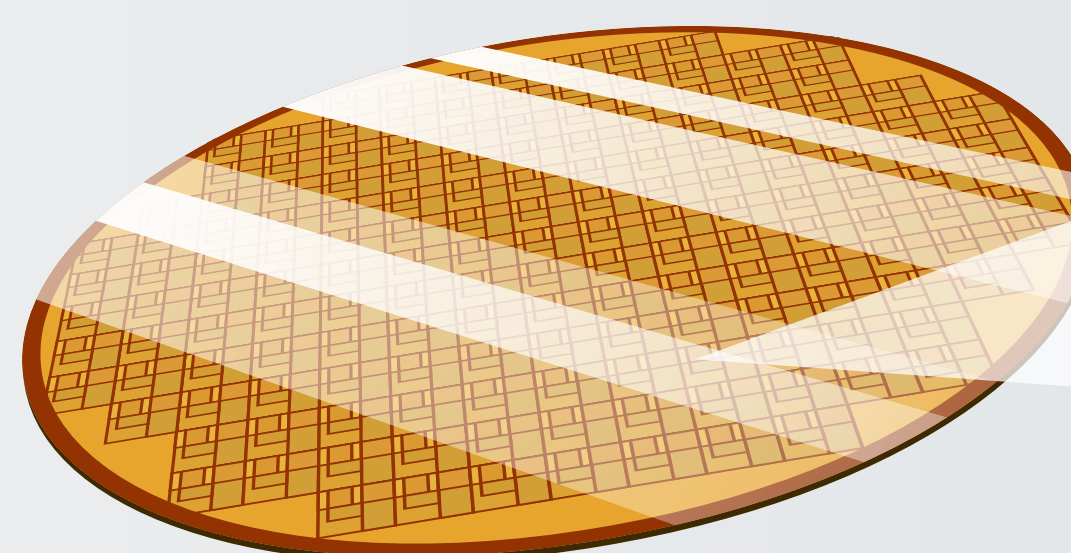
All for dreams

NATS[®]-1304

SiCパワーデバイスの高信頼性ダイレベル試験システム High-Reliability Die-Level Testing System of SiC Power Devices



量産対応の高速・高信頼性 - KGD検査システム
High-Speed, High-Reliability KGD Testing for Mass Production



SiC-Wafer

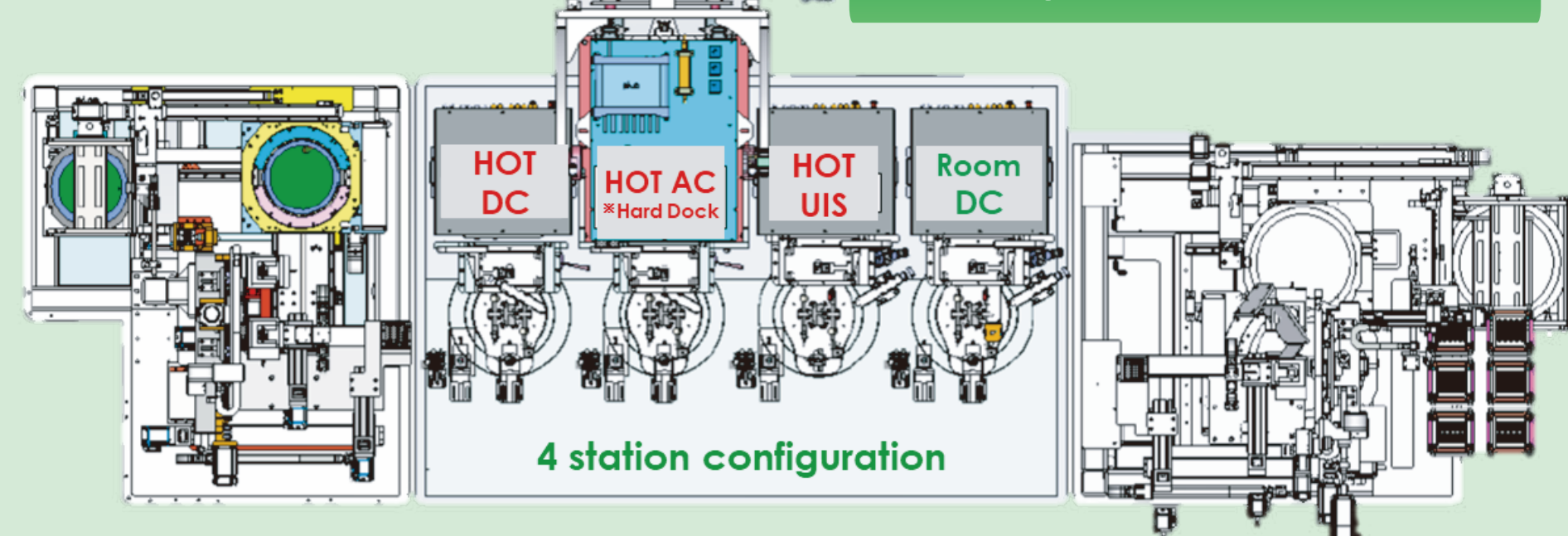


SiC-MOSFET Die

TOP View

AC - Hard dock*
DC - Cable dock

※Images shown is hard dock



Feature

最大4ステーションまで対応、温度ゾーンは自由に組み合わせ可能

Support up to 4 stations, free mixing of temperature zones

生産性を極限まで高める
高速ハンドラソリューション
テスト構成は自由にカスタマイズ可能

High-Speed handler solution to achieve utmost UPH and test stations can be freely configured

UPH > 2500

高電圧・大電流・高温対応の
真のKGDテストをサポート

Supporting true High-Voltage, High-Current, High-Temperature KGD Test

State of the Art in-situ probe tip cleaning to assure high yield test

超低Ls構造採用で、
高品質なKGD - AC検査を実現

HExtremely Low-stray inductance to enable high quality KGD AC (Short-circuit) Test

Ls: 20nH ± 2nH

業界トップクラス！
300ns以下の【瞬速】保護時間

NIDEC offers advanced multi-protection

≤ 300ns protection time

maximizing protection for probes and system

次世代SiC MOSFET対応 KGDテストソリューション

DCからACまでの幅広い検査に対応し、短絡耐性や高温動作テストを実現

AC・UISなどの動的ストレス試験により、SiCデバイス特有のスタッキング欠陥を高精度に検出します



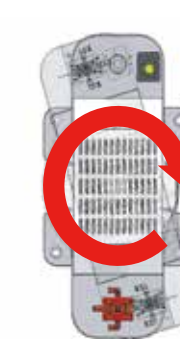
Die Pick-up / Loader Section



Four Testing Sections



Intuitive GUI



検査ステーションは回転式で
UPHを向上

The inspection station is rotary-type to improve UPH

Waferレベル検査も当社にお任せください
Leave Wafer-Level Testing to us!



Items	静特性検査 <DC> Static Test Station	動特性検査 <AC> Dynamic Test Station (Double Pulse+Short Circuit Test)	アバランシェ試験 <UIS*> UIS Test Station (Avalanche breakdown test)
Test item	IGSS, VGS(th), IDSS, V(BR)DSS, RDS(ON), VSD(VF)	Tdon, Tdoff, Tr, Tf, Eon, Eoff, didton, didtoff, dvdton, dvdtoff, Irrm, Vrm, Trr, Qrr, Vscm, Isc	IAS, VDS, EAS
Accuracy	IGSS : ±(0.1% + 100pA) (@10nA) VGS(th) : ±(0.1% + 1mV) (@20mV) IDSS : ± (0.2% + 50pA) (@10nA) V(BR)DSS : ± (0.05% + 2V) (@3000V) RDS(ON) : ± (0.01% + 10μΩ) (@20V/500A) VSD(VF) : 0.2% ± 10mV (0~20V)	Ids: ± 2% Vgs: ± 2% Vds: ± 2% Lload: 300uH	IAS: ±2% VDS: ±2% EAS: ±4%
Performance/Range	3000V, 500A	1500V, 1000A (DPT) /2000A (SCT)	3000V, 200A, 2J
Temperature range	RT to 200°C	RT to 200°C	RT to 200°C

* UIS: Unclamped Inductive Switching

国内拠点

・京都(本社)
617-0003 京都府向日市森本町東ノ口1-1 ニデックパークC棟
TEL 075-280-8101 / FAX 075-280-8106
・名古屋
503-0974 岐阜県大垣市久瀬川町1-3
TEL 0584-83-7680 / FAX 0584-83-7685
・東京
141-0032 東京都品川区大崎1丁目20番13号 Nidec東京ビル
TEL 03-3494-7970 / FAX 03-3494-0793

海外拠点

・台湾 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY TAIWAN CORPORATION
・韓国 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY KOREA CO., LTD.
・中国 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY ZHEJIANG CORPORATION
・タイ NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY THAILAND CO., LTD.
・マレーシア NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.
・ベトナム NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.
・インド NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
・カナダ NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CANADA CORPORATION

ニデックアドバンステクノロジー株式会社
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CORPORATION